

半导体学报

第 10 卷 第 8 期 1989 年 8 月

目 录

- 势阱形状对电场下量子阱子带和激子能移的影响.....
.....朱嘉麟 唐道华 顾秉林 熊家炯 (565)
- 杂质对金属-半导体界面电子态的影响.....杨宗献 张涛 王勉 (576)
- 半绝缘砷化镓 EPR 谱的异常退火特性.....
.....韩洪涛 葛惟锬 林兰英 吴恩 吴书祥 晏懋洵 (582)
- 非晶硅电子结构的 EHT 理论研究.....韩圣浩 戴国才 (587)
- LPCVD 淀积速率分布的解析表达式.....王永发 张世理 王季陶 (592)
- a-Si:H/a-C:H 超晶格的界面研究.....梅向阳 廖显伯 陆珉华 孔光临 (601)
- MBE 高掺杂 n-GaAs:Si 和 p-GaAs:Be 的光致发光谱.....
.....胡天斗 许继宗 梁基本 庄蔚华 (607)
- 退火气氛中痕量氧在反应形成 Pt 硅化物中的作用.....
.....李映雪 武国英 张国炳 王佑祥 (615)
- 大剂量氧离子注入形成 SOI 结构的研究.....
.....陈南翔 苗伟 王忠烈 黄敞 (620)
- 硅中离子注入掺杂原子的增强扩散系数的分布.....曾论 (626)
- 研究简报**
- 从势垒区电压波形对照 GaAs 液结的光调制反射与电调制反射.....
.....曹霞芬 赵冬 蒋文洁 郑国祥 钱佑华 (632)
- MBE $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}(001)$ 系统晶格失配的研究.....
.....王玉田 李成基 任庆余 (637)
- InP 中的 Be、P 共注入及其退火特性研究.....张永刚 富小妹 潘慧珍 (641)